

Содержание

● Электронные свойства полупроводников

Жолудев М.С., Румянцев В.В., Морозов С.В.

Расчет резонансных состояний кулоновских акцепторов в бесщелевых полупроводниках 391

Гурбанов Г.Р., Джафаров Т.А., Адыгезалова М.Б.

Термоэлектрические свойства твердых растворов с катионным и анионным замещением на основе слоистого тетрадимитоподобного соединения $\text{GeSnSb}_4\text{Te}_8$ 397

El Amine Monir M.

Theoretical Study of the Structural and Electronic Properties of the Tetragonal Chalcopyrite Compound ZnTiS_2 402

● Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Олешко В.И., Вильчинская С.С., Морозова Н.К.

Особенности спектров люминесценции $\text{ZnSe} \cdot \text{O}$ с привлечением теории антипересекающихся зон 403

Калинушкин В.П., Гладилин А.А., Уваров О.В., Миронов С.А., Ильичев Н.Н., Студеникин М.И., Чапнин В.А., Тимофеева Н.А., Гаврищук Е.М., Родин С.А., Иконников В.Б., Новиков Г.Г.

Исследование пространственного распределения люминесценции в диапазоне 0.44–0.75 мкм CVD-ZnSe, легированного алюминием и железом 410

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Юрасов Д.В., Байдакова Н.А., Вербус В.А., Гусев Н.С., Морозова Е.Е., Шенгуров Д.В., Яблонский А.Н., Новиков А.В.

Формирование и исследование оптических свойств локально растянутых Ge микроструктур, встроенных в резонаторы 420

Соболева О.С., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.

Изотипные гетероструктуры $n\text{-AlGaAs}/n\text{-GaAs}$, оптимизированные для эффективной межзонной излучательной рекомбинации при накачке электрическим током 427

Агеева Н.Н., Бронева И.Л., Забегаев Д.Н., Кривоносов А.Н.

Влияние разогрева носителей заряда собственным стимулированным пикосекундным излучением в GaAs на линейное возрастание на фронте и длительность спектральной компоненты этого излучения 434

Ayachi M., Ayad F., Djelloul A., Benharrat L., Anas S.

Synthesis and Characterization of Ni-Doped ZnO Thin Films Prepared By Sol–Gel Spin-Coating Method 441

Jagtap S.M., Gond V.J.

Bulk Fin-FET Strategy at Distinct Nanometer Regime for Measurement of Short-Channel Effects 442

● Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Александрович Е.В., Александрович А.Н., Быстров С.Г., Михеев Г.М.

Морфология поверхности и оптические свойства стеклообразных пленок селена после лазерной модификации 443

Кастро-Арата Р.А., Грабко Г.И., Кононов А.А., Анисимова Н.И., Крбал М., Колобов А.В.

Перенос заряда в тонких слоях стеклообразной гибридной системы $\text{Ge}_{28.5}\text{Pb}_{14.5}\text{Fe}_{0.5}\text{S}_{56.5}$ 450

● Физика полупроводниковых приборов

Дубинов А.А., Румянцев В.В., Фадеев М.А., Уточкин В.В., Морозов С.В.

Оптимизация диэлектрического волновода для лазерных структур дальнего инфракрасного диапазона на основе $\text{HgTe}/\text{CdHgTe}$ 455

Подоскин А.А., Романович Д.Н., Шашкин И.С., Гаврина П.С., Соколова З.Н., Слипченко С.О., Пихтин Н.А.

Анализ пороговых условий и эффективности генерации замкнутых мод в больших прямоугольных резонаторах на основе лазерных гетероструктур $\text{AlGaAs}/\text{GaAs}/\text{InGaAs}$ 460

Подоскин А.А., Гаврина П.С., Головин В.С., Слипченко С.О., Романович Д.Н., Капитонов В.А., Мирошников И.В., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А.

Исследование пространственной динамики включения лазера-тиристора (905 нм) на основе многопереходной гетероструктуры $\text{AlGaAs}/\text{InGaAs}/\text{GaAs}$ 466

Yadava N., Chauhan R.K.

RF Performance Investigation of NiO Pocket on Ga_2O_3 -Based Hetero-MOSFET 473

Pal S., Kumar B., Mittal P.

Impact of Different Gate Dielectrics on OTFT-Driven Active Matrix OLED Pixel Circuits 474

● Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур

Стовляга Е.Ю., Курдюков Д.А., Кириленко Д.А., Смирнов А.Н., Швидченко А.В., Яговкина М.А., Голубев В.Г.

Темплатный метод синтеза монодисперсных наночастиц MoS_2 475

● Персоналии

К 80-летию со дня рождения Владимира Алексеевича Сабликова 481